

ESPA21(40kV)

富士小電力ダイオード

高圧整流ダイオード

HIGH VOLTAGE SILICON DIODE

ESPA21は、ディストリビュータ・レス自動車イグニションシステム用に開発され、メサ型積層シリコンチップをガラスにて封止した高圧整流ダイオードを、更にエポキシ樹脂で封止した小型高信頼性高圧整流ダイオードです。

ESPA21 is epoxy resin encapsulated type high reliability and small sized high voltage silicon diode for distributor-less automobile ignition system which inner diode is sealed a miltilayed mesa type silicon chip by glass.

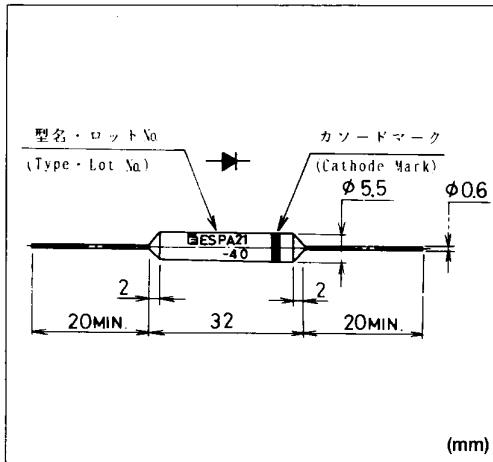
■特長：Features

- 超小型 Supersmall size
- 高信頼性 High reliability
- 高耐熱性 High temperature resistivity

■用途：Applications

- ダイオード分配方式ディストリビュータ・レス・イグニッションシステム Distributor-less ignition system for diode distributed style.
- その他高圧電源整流用 Others.

■外形寸法：Outline Drawings



(mm)

■カソードマーク：Cathode Mark

形 式 Type	マーカ Mark
ESPA21-40	

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	ESPA21 -40	Units	Conditions
ピーク繰返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	40	kV	
平均順電流 Average Forward Current	I _{F(AV)}	10	mA	T _a =25°C, 抵抗負荷 Resistive Load (RL)
サージ電流 Surge Current	I _{FSM}	1	A _p	60Hz, 正弦半波1サイクル One shot surge of 60Hz half sine wave.
接合部温度 Allowable Junction Temperature	T _j	150	°C	
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-55~150	°C	

●電気的特性：Electrical Characteristics

Items	Symbols	ESPA21 -40	Units	Conditions
順電圧 Forward Voltage Drop	V _F	60	V	T _j =25°C, I _F =10mA
逆電流 Reverse Current	I _{R1}	5	μA	T _j =25°C, V _R =34kV
逆電流 Reverse Current	I _{R2}	10	μA	T _j =25°C, V _R =40kV

■特性曲線：Characteristics

